

| | | | |
|----------|--|-----|--|
| 科目 | 半導体工学 (Semiconductor Engineering) | | |
| 担当教員 | 井上 靖朗 非常勤講師 | | |
| 対象学年等 | 電気工学科・4年・通年・必修・2単位 (学修単位III) | | |
| 学習・教育目標 | A2(100%) | | |
| 授業の概要と方針 | これまで学習した半導体デバイスの基礎知識に降伏や劣化などを含め,より深い知識を身につける.さらに,その半導体デバイス作製に用いられる成膜装置やプロセスの基礎についても学ぶ. | | |
| | 到達目標 | 達成度 | 到達目標別の評価方法と基準 |
| 1 | 【A2】エネルギーバンド構造を書くことができ,基板の不純物量からフェルミレベルのエネルギーを計算により算出できる. | | エネルギーバンドとP-N接合の特性について前期中間試験で評価する. |
| 2 | 【A2】P-N接合のI-V特性について降伏やトンネルダイオードについて説明でき,金属と半導体の接触を定性的に理解する. | | バイポーラトランジスタや金属と半導体の接触について前期定期試験で評価する. |
| 3 | 【A2】酸化膜内の欠陥について理解し,欠陥が及ぼすデバイスへの影響と欠陥低減技術を理解する. | | MOSキャパシタのC-V特性や酸化膜内の欠陥が及ぼす影響について後期中間試験で評価する. |
| 4 | 【A2】MOSFETの基本原理や特性評価の方法について説明することができる. | | MOSFETの基本原理や特性評価の方法について後期定期試験で評価する. |
| 5 | 【A2】MOSデバイスの基本的作製工程や成膜装置について説明することができる. | | MOSFETの作製方法やその特性について後期定期試験で評価する. |
| 6 | 【A2】フラッシュメモリやSOIなどのMOSFETに類似したデバイスについて説明できる. | | フラッシュメモリやSOIなどのMOSFETに類似したデバイスについて後期定期試験で評価する. |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 総合評価 | 成績は,試験100% として評価する.100点満点で60点以上を合格とする. | | |
| テキスト | 半導体工学 第2判 高橋清著 | | |
| 参考書 | 半導体デバイス S.M.ジー | | |
| 関連科目 | 電気材料,応用物理,電子工学 | | |
| 履修上の注意事項 | 3年生の電子工学で修得した半導体デバイスの基本的動作原理に,界面準位などの欠陥や降伏などの劣化を含め,エネルギーバンドを用いてより深い知識を習得する.また,5年生の電気材料とも関連が深いため十分に理解して欲しい. | | |

授業計画(半導体工学)

| | テーマ | 内容(目標・準備など) |
|----|---|--|
| 1 | 半導体について | 半導体の性質と、半導体に主として用いられる単結晶Si基板の作製方法について学習する。 |
| 2 | Si基板中でのキャリアの振る舞い | Si基板中を流れるキャリアが起こす、ドリフト電流、フォノン散乱、有効質量などについて学習する。 |
| 3 | シュレーディンガー方程式の概要 | 半導体の基本となるシュレーディンガー方程式について説明する。 |
| 4 | 局在単位の発生と種類 | 局在単位の発生や深い単位、浅い単位、界面単位について説明する。 |
| 5 | Shockley-Readモデル | Shockley-Readモデルを用いてキャリアの生成メカニズムについて説明する。 |
| 6 | P-N接合の作製方法 | 電圧印加前のP-N接合の空乏層、内部電位発生機構を含めた基本特性と、その作製の方法について説明する。 |
| 7 | P-NダイオードのI-V特性 | 順バイアス、逆バイアス印加後のP-Nダイオードの基本的な特性について説明する。 |
| 8 | 中間試験 | 1回～7回までの内容について中間試験を行なう。 |
| 9 | 中間試験の解説 | 中間試験の解説を行う。 |
| 10 | P-Nダイオードの降伏機構 | P-Nダイオードの降伏の機構について説明する。 |
| 11 | トンネルダイオード | トンネルダイオードの電流電圧特性について説明する。 |
| 12 | バイポーラトランジスタの作製方法と増幅機構 | バイポーラトランジスタの作製方法と増幅機構について学習する。 |
| 13 | 金属-半導体の接合I | 金属-半導体接合の特性に関与する、電子親和力や仕事関数や金属蒸着装置について説明する。 |
| 14 | 金属-半導体の接合II | 仕事関数と電子親和力によって、オーミック接触やショットキー接触になることを説明する。 |
| 15 | 復習 | 10回～14回までの内容について復習を行なう。 |
| 16 | ショットキーダイオード | ショットキーダイオードの基本特性について説明する。 |
| 17 | 理想MOSダイオードの電気特性と酸化膜作製方法について | 理想MOSダイオードの電気特性である蓄積、空乏、反転について説明し、SiO ₂ の作製方法を例に、熱酸化法、CVD法について説明する。 |
| 18 | MOSダイオードのC-V特性 | C-V特性の周波数依存性や、しきい値電圧のシフトなどからの評価について説明する。 |
| 19 | 実際のMOSダイオード | 界面単位を含んだ実際のMOSダイオードでの理想MOSダイオードとの特性の違いを説明する。 |
| 20 | 酸化膜内に存在する欠陥の種類 | 固定電荷や界面単位や可動イオンについて説明し、クリーンルームのクリーン度の定義について学習する。 |
| 21 | 酸化膜内に存在する欠陥がデバイスに与える影響 | 欠陥が存在する場合のC-V特性の変化などについて説明する。また界面単位等の欠陥低減技術を学習する。 |
| 22 | LSI技術 | LSI(集積回路)について学習し、MOSFETが中心的役割を担っていることを学習する。 |
| 23 | 中間試験 | 17回～22回までの内容について中間試験を行なう。 |
| 24 | 中間試験の解説 | 中間試験の解説を行う。 |
| 25 | MOSFETの作製方法 | MOSFETの作製方法について学習する。 |
| 26 | MOSFETの基本動作 | 入力特性、出力特性やエンハンスメント型、ディプレッション型について説明する。 |
| 27 | 界面単位の影響 | 界面単位がトランジスタの動作にどのような影響を及ぼすか学習する。 |
| 28 | MOSFETの特性解析 | 入力特性からしきい値電圧、相互コンダクタンスなどの特性の解析方法について学習する。 |
| 29 | フラッシュメモリの原理 | フラッシュメモリの原理について説明する。 |
| 30 | SOI技術 | 次世代FETのSOI-FET技術について説明する。 |
| 備考 | <p>本科目の修得には、60時間の授業の受講と30時間の自己学習が必要である。</p> <p>前期、後期ともに中間試験および定期試験を実施する。前期、後期ともに中間試験および定期試験を実施する。</p> | |